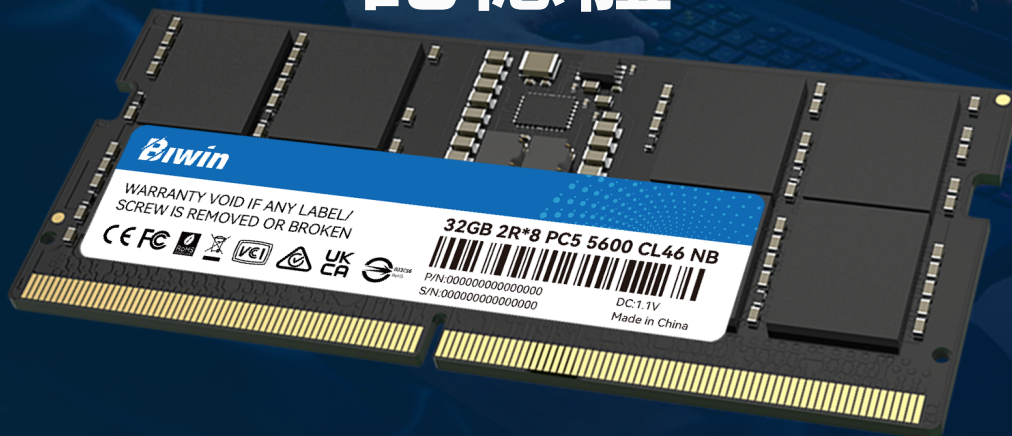




RS200 DDR5 記憶體



數據傳輸速度
高達5600 MT/s



低功耗



可靠耐用



On-Die ECC
即時錯誤修正

Biwin RS200 DDR5 數據傳輸速度高達 5600 MT/s，輕鬆實現多工處理。在提高效率的同時，工作電壓低至1.1V，功耗低於DDR4。加入 PMIC (Power Management IC) 電源管理晶片提高電源管理效率，並選用優質IC，帶來更穩定的數據傳輸，可靠耐用。Biwin RS200適用於DDR5筆記型電腦和迷你電腦 (NUC)，包括聯想、惠普、華碩、宏碁、微星等品牌。

► 產品特點

高性能 帶來效率精進

DDR5新一代，存取效率升級。更快的數據處理速度，滿足更多IO密集型運算需求，辦公、建模、剪輯、遊戲流暢運行，同樣支持高性能AI計算，助力深度學習模型訓練。

低電耗 效率持續在線

Biwin RS200有效降低功耗，帶來持久高性能體驗。DDR5工作電壓低至1.1V，相比DDR4記憶體，記憶體工作產生的熱能得以減少，保障設備高強度運行的穩定性。

PMIC 電源管理晶片 數據傳輸更穩定

DDR5記憶體模組加入PMIC (Power Management IC)，由主板轉移至記憶體PCB板，走線距離縮短，提高電源管理效率和供電穩定性，保障數據完整，提升整體傳輸速度。

On-die ECC 即時錯誤修正 提高數據準確性

Biwin RS200加入On-die ECC 即時錯誤修正機制，動態修正數據存取錯誤，降低數據洩露風險，保障記憶體穩定性和使用可靠性。

► 佰維存儲

佰維存儲專注於半導體儲存技術的研發與製造，賦能尖端設備，引領數位創新浪潮。佰維消費級品牌提供一系列優質的固態硬碟、記憶體模組、記憶卡及相關配件產品，助力設備發揮最佳效能。

佰維以儲存技術為核心，自建完整的晶片封裝、測試、生產產線，配備軟硬體實驗室、無塵室等頂尖設備與技術，鑄就卓越品質，確保每一款產品都具備出色且穩定的效能。

► 產品規格

型號	Biwin RS200
記憶體類型	DDR5 SODIMM
容量	16 GB (16 GB x 1) / 32 GB (32 GB x 1)
頻率	4800 / 5600 MT/s
CL值	CL40 / CL46
Rank	1R x 8 / 2R x 8
工作電壓	1.10 V
Pin	262 Pin
尺寸(長x寬x高)	69.60 × 30.00 × 3.80 mm (max)
工作溫度	0°C to - 85°C
儲存溫度	-55°C to - 100°C
認證	FCC, CE, KCC, BMSI, RCM, WEEE, RoHS, UKCA, VCCI
保固	終身有限保固

► 訂購資訊

Part Number	容量	Rank	速率 (MT/s)	時序	電壓	保固
BD5SD16G48C40	16 GB	1R x 8	DDR5-4800	CL40-39-39-77	1.10 V	終身
BD5SD16G56C46	16 GB	1R x 8	DDR5-5600	CL46-45-45-90	1.10 V	終身
BD5SD32G48C40	32 GB	2R x 8	DDR5-4800	CL40-39-39-77	1.10 V	終身
BD5SD32G56C46	32 GB	2R x 8	DDR5-5600	CL46-45-45-90	1.10 V	終身

1. 以上數據為BIWIN實驗室測試結果，僅供參考。實際使用可能因設備和環境差異有所不同。
2. 產品生命週期內進行持續維護更新，規格如有變更，恕不另行通知。
3. 以上產品圖片為效果圖，具體請以實物為準。
4. 並非所有產品在全球的所有地區均有銷售。
5. 高頻記憶體購買指南：超頻記憶體需要配備匹配的主機板與處理器方能發揮其性能。購買前請確認您的主機板及CPU是否支援所選規格。安裝後啟動XMP以享受超頻速度。
6. 更多詳情，請訪問官方網站：www.biwintech.com。

全球總部:

深圳佰維存儲科技股份有限公司
廣東省深圳市南山區留仙大道眾冠紅花嶺工業南區二區4、8棟
support@biwintech.com
www.biwintech.com

美國總部:

BIWIN TECHNOLOGY LLC
8725 NW 18th Terrece Suite 400, Miami, FL 33172, U.S.A
+1 (305) 456-3288

BIWIN SEMICONDUCTOR (HK) COMPANY LIMITED (台北辦事處)
臺北市內湖區新湖二路158號2樓, 臺灣
+886 (2) 2795-282

